

05; 01

ДИНАМИКА ОБЪЕМНОГО ЗАХВАТА БЫСТРЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В КАНАЛЫ ИЗОГНУТОГО КРИСТАЛЛА

Н. А. Кудряшов, С. В. Петровский, М. Н. Стрижанов

В данной работе предложены кинетические уравнения, описывающие динамику захвата быстрых положительно заряженных частиц в плоскостные каналы ИК и деканалирования, разработан алгоритм численного решения соответствующей краевой задачи. В единой модели учтены торцевой и объемный механизмы захвата. Проанализирована зависимость доли каналированных частиц от угловых параметров пучка и толщины кристалла. Показано, что зависимость захвата от заряда ионов Z_1 и их энергии обладает «масштабной инвариантностью» и определяется «масштабным параметром» $w = pv/Z_1$.

На возможность управления траекториями быстрых заряженных частиц (БЗЧ) с помощью изогнутого кристалла (ИК) было указано в [1]. Обсуждаются два механизма захвата БЗЧ в каналы изогнутых плоскостей (осей) ИК [2]. При падении пучка БЗЧ на переднюю поверхность кристалла часть частиц пучка «заселяет» каналированные состояния («торцевой» захват). Эффективность торцевого захвата ограничена требованием малости угла влета (угловой расходимости) пучка Θ_0 ($\Delta\Theta_0 \leq \Theta_L$ (где Θ_L — угол Линдхарда), что значительно снижает «светосилу» поворотных устройств на основе ИК. В экспериментах ЛИЯФ [3, 4] был предложен и экспериментально подтвержден механизм «объемного» захвата (ОЗ). Суть этого явления состоит в том, что условия захвата в режим каналирования могут возникнуть внутри объема кристалла — в областях, где траектория БЗЧ совпадает с касательной к изогнутой плоскости (оси). Из геометрических соображений очевидно, что угловой диапазон объемного захвата равен углу между крайними касательными и легко может достигать 1—10 мрад. Преобладающим механизмом (97 % в работе [5]) потерь поперечной энергии БЗЧ, приводящим к ОЗ, является, по-видимому, механизм многократного рассеяния (МР), рассмотренный в [2, 6], причем в [2] предложена кинематическая теория ОЗ. В [6] выполнено прямое компьютерное моделирование кинетики ОЗ в ИК.

В настоящее время, однако, актуальной является задача количественного расчета динамики ОЗ в каналы ИК с последующим вычислением эффективности использования ИК для поворота пучков релятивистских заряженных частиц.

Кинетические уравнения

Функция распределения (ФР) для БЗЧ, движущихся в поле изогнутых плоскостей кристалла, удовлетворяет уравнению Больцмана

$$\frac{\partial f(t, p_x, x)}{\partial t} + v_x \frac{\partial f}{\partial x} + F_x \frac{\partial f}{\partial p_x} = I_{\text{эф}}, \quad (1)$$

где t — время (глубина); p_x, v_x — локальные поперечные к плоскостям импульс и скорость; $F_x = -\partial U_{\text{эф}}/\partial x$ — поперечная сила; $U_{\text{эф}}(x) = U(x) - pvx/R$ — эффективный потенциал ИК; $U(x)$ — межплоскостной потенциал в прямом

кристалле; p, v — импульс и скорость частиц; R — радиус изгиба кристалла; $x=r-R$ — поперечная (радиальная) координата.

Производя стандартное разложение интеграла столкновений I_{st} [7], получим

$$I_{st} = \int dq_x [f(t, p_x - q_x, x) w(q_x, p_x - q_x, x) - f(t, p_x, x) w(q_x, p_x, x)] \approx \approx \frac{\partial^2}{\partial p_x^2} [\langle q_x^2(x) \rangle f(t, p_x, x)], \quad (2)$$

где q_x — передаваемый импульс; $w(q_x, p_x, x)$ — вероятность рассеяния в единицу времени; $\langle q_x^2(x) \rangle = \int dq_x q_x^2 w(q_x, p_x, x) = p^2 v \langle \Delta \theta_x^2(x) / \Delta s \rangle$. Здесь $\langle \Delta \theta_x^2(x) / \Delta s \rangle$ — средний квадрат угла МР, который можно представить в виде

$$\left\langle \frac{\Delta \theta_x^2(x)}{\Delta s} \right\rangle = \left\langle \frac{\Delta \theta_n^2(x)}{\Delta s} \right\rangle + \left\langle \frac{\Delta \theta_z^2(x)}{\Delta s} \right\rangle, \quad (3)$$

где $\left\langle \frac{\Delta \theta_n^2(x)}{\Delta s} \right\rangle = \frac{1}{2} \left\langle \frac{\Delta \theta_{am}^2}{\Delta s} \right\rangle \rho_n(x) d$ отвечает рассеянию на колеблющихся ядрах, $\rho_n(x)$ — усредненная вдоль плоскостей плотность ядер; $\langle \Delta \theta_{am}^2 / \Delta s \rangle = (E_s / pv)^2 L_{\text{рад}}^{-1}$ ($E_s = 21$ МэВ, $L_{\text{рад}}$ — радиационная длина). Аналогично $\langle \Delta \theta_z^2(x) / \Delta s \rangle$ отвечает рассеянию на электронах и определяется усредненной вдоль плоскостей электронной плотностью.

Рассмотрим отдельно каналированную и неканалированную фракции пучка. Для каналированной БЗЧ переходим в (1), (2) к переменным (t, ϵ_{\perp}, x) , т. е. $f_1(t, \epsilon_{\perp}, x) = f(p_x, x, t)$, где $\epsilon_{\perp} = p_x^2 / 2E + U_{\text{eff}}(x)$ — поперечная энергия в ИК (причем $\epsilon_{\perp} < \epsilon_c$, ϵ_c — глубина потенциальной ямы $U_{\text{eff}}(x)$). Существенное упрощение уравнения возникает, если использовать условие «статистического равновесия» Линдхарда $\partial f_1 / \partial x = 0$, достигаемого на глубинах $\sim 10^3 - 10^6 \text{ \AA}$ [8, 9]. Имеем тогда

$$\frac{1}{v_x(x, \epsilon_{\perp})} \frac{\partial f_1(t, \epsilon_{\perp})}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \epsilon_{\perp}} \left[v_x(x, \epsilon_{\perp}) \langle q_x^2(x) \rangle \frac{\partial f_1(t, \epsilon_{\perp})}{\partial \epsilon_{\perp}} \right], \quad (4)$$

где $v_x(x, \epsilon_{\perp}) = \sqrt{2E^{-1}(\epsilon_{\perp} - U_{\text{eff}}(x))}$.

Заметим, что уравнение (4) определяет ФР в классически разрешенной области $\epsilon_{\perp} > U_{\text{eff}}(x)$. В классически запрещенной области $\epsilon_{\perp} < U_{\text{eff}}(x)$ имеем $f_1 = 0$ [9, 10]. Вводя ФР по поперечным энергиям (усредненную по поперечной координате)

$$\varphi_1(\epsilon_{\perp}, t) = \frac{1}{d} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{v_x(x, \epsilon_{\perp})} f_1(t, \epsilon_{\perp}) = \frac{T_1(\epsilon_{\perp})}{d} f_1(t, \epsilon_{\perp}) \quad (5)$$

(d — период межплоскостного потенциала, $T_1(\epsilon_{\perp}) = \int dx / v_x(x, \epsilon_{\perp})$ — полупериод движения с энергией ϵ_{\perp} , $x_{1,2}$ — классические точки поворота), получим из (4) для ФР каналированных частиц уравнение диффузионного типа [9, 10]

$$\frac{\partial \varphi_1(\epsilon_{\perp}, t)}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \epsilon_{\perp}} \left\{ D_1(\epsilon_{\perp}) \frac{\partial}{\partial \epsilon_{\perp}} \left[\frac{\varphi_1(\epsilon_{\perp}, t)}{T_1(\epsilon_{\perp})} \right] \right\}. \quad (6)$$

Здесь

$$D_1(\epsilon_{\perp}) = 2^{1/2} (pv)^{3/2} \int_{x_1}^{x_2} dx \sqrt{\epsilon_{\perp} - U_{\text{eff}}(x)} \left\langle \frac{\Delta \theta_x^2(x)}{\Delta s} \right\rangle \quad (7)$$

— коэффициент диффузии каналированных частиц.

Для неканалированных частиц переходим в уравнении (1) к переменным (t, p'_{\perp}, x) , где $p'_{\perp} = \sqrt{2E \epsilon'_{\perp}}$ — «поперечный импульс», $\epsilon'_{\perp} = p_x^2 / 2E + U(x)$ — «поперечная энергия в прямом кристалле» ($\epsilon'_{\perp} > U_0$, где U_0 — максимальное

значение $U(x)$). Аналогично приведенному выше выводу получаем для ФР неканализованных частиц уравнение конвективно-диффузионного типа

$$\frac{\partial f_2(p'_1, t)}{\partial t} + \Delta U_0 \frac{\partial}{\partial p'_1} \left[\frac{f_2}{v'_1 T_2(\epsilon'_1)} \right] = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial p'_1} \left[\frac{D_2(\epsilon'_1)}{v'_1} \frac{\partial}{\partial p'_1} \left(\frac{f_2}{v'_1 T_2} \right) \right], \quad (8)$$

где $v'_1 = v(p'_1/p)$ — «поперечная скорость», $\Delta U_0 = pvd/R$.

Отметим, что выражения для периода движения неканализованных частиц $T_2(\epsilon'_1)$ и коэффициента диффузии $D_2(\epsilon'_1)$ могут быть получены из соответствующих выражений для $T_1(\epsilon_1)$ и $D_1(\epsilon_1)$ заменой $\epsilon_1 \rightarrow \epsilon'_1$ и области интегрирования $[x_1, x_2] \rightarrow [0, d]$.

Для учета обмена частицами между канализованной и неканализованной фракциями пучка оценим изменение поперечной энергии иона вследствие МР (при $\epsilon_1 \sim \epsilon_0$) за период движения

$$\Delta \epsilon_1 \sim pv \Theta_c \sqrt{\left\langle \frac{\Delta \Theta_{am}}{\Delta s} \right\rangle} \frac{d}{\Theta_c} \sim \left(\frac{2\epsilon_c}{pv} \right)^{1/4} \left(\frac{d}{L_{\text{пад}}} \right)^{1/2} E_s, \quad (9)$$

где $\Theta_c = \sqrt{2\epsilon_c/pv}$ — критический угол канализования для ИК.

Рассмотрим в случае «интенсивного» МР $\Delta \epsilon_1 \gg \Delta U$, где ΔU — изменение потенциала ИК на межплоскостном периоде (для экспериментов [3, 4], например, имеем $\Delta \epsilon_1 \sim 16$ эВ, $\Delta U \sim 1$ эВ). В этом случае можно пренебречь влиянием упругого отражения неканализованных частиц от асимметричного потенциального барьера ИК [11] на процесс захвата в каналы ИК. Математически это означает соответствующую сшивку (с учетом различной нормировки) ФР и потоков канализованных (при $\epsilon_1 = \epsilon_0$) и неканализованных (при $\epsilon'_1 = U_0$) частиц.

Получим начальные условия для уравнений (6), (8). Пусть $f_0(p_{0x})$ — распределение пучка частиц по поперечным импульсам (углам) до влета в ИК. Усредняя по поперечной координате, получим начальное условие для ФР канализованных частиц

$$\varphi_1(\epsilon_1, 0) = \frac{1}{d} \left(\frac{E}{2} \right)^{1/2} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx f_0(p_{0x} = \sqrt{2E(\epsilon_1 - U_{\text{эф}}(x))})}{\sqrt{\epsilon_1 - U_{\text{эф}}(x)}}. \quad (10)$$

Аналогично можно получить начальное условие для ФР неканализованных частиц.

Зарядово-энергетическая «масштабная инвариантность»

Рассмотрим зарядовую и энергетическую зависимости параметров канализования ионов. Введем «масштабный параметр» $w = pv/Z_1$. В прямом кристалле критический угол канализования $\Theta_L = \sqrt{2U_0/pv} \sim w^{-1/2}$ убывает с ростом w . Убывает также средний квадрат угла МР в кристалле $\langle \Delta \Theta_x^2(x)/\Delta s \rangle \sim w^{-2}$. Длина деканализования наоборот увеличивается $l_g \sim \Theta_L^2 / \langle \Delta \Theta_x^2/\Delta s \rangle \sim w$. Нетрудно видеть, что подобная «масштабная инвариантность» имеет место и в ИК. Эффективный потенциал ИК имеет вид $U_{\text{эф}}(x) = Z_1 [U_1(x) - wx/R]$, где $U_1(x)$ — межплоскостной потенциал для протонов. Глубина потенциальной ямы имеет вид $\epsilon_c = Z_1 f(w)$. Отсюда следует, что критический угол канализования для ИК $\Theta_c = \sqrt{2f(w)/w}$ и длина деканализования $l_c \sim wf(w)$ являются функциями параметра w .

Уравнение (6) для ФР канализованных ионов в безразмерном виде имеет вид

$$\frac{\partial \psi_1(y, \tau)}{\partial \tau} = 2 \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \Phi_1(y) \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\psi_1(y, \tau)}{x_1(y)} \right] \right\}, \quad y \leq 1, \quad (6')$$

где $y = \epsilon_1/\epsilon_c$, $\psi_1(y, \tau) dy = \varphi_1(\epsilon_1, t) d\epsilon_1$, $\tau = vt/l_c$, $u_{\text{эф}}(\xi, w) = U_{\text{эф}}(x)/\epsilon_c$, $\xi = x/d$.

$$\Phi_1(y) = \int_{\xi_1}^{\xi_2} d\xi \sqrt{y - u_{\text{eff}}(\xi, w)} d[\rho_n(\xi) + \beta Z_2^{-2} \rho_e(\xi)],$$

$$x_1(y) = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{d\xi}{\sqrt{y - u_{\text{eff}}(\xi, w)}}.$$

Уравнение (6') обладает требуемой «масштабной инвариантностью». В аналогичном виде можно записать уравнение (8) для неканализованных ионов и соответствующие начальные условия, что и доказывает «масштабную инвариантность» каналирования в ИК.

Результаты численных расчетов

Уравнения (6), (8) с соответствующими начальными условиями решались конечно-разностным способом на ЭВМ. Возникающая система сеточных уравнений решалась стандартным методом трехточечной прогонки. Размеры сетки

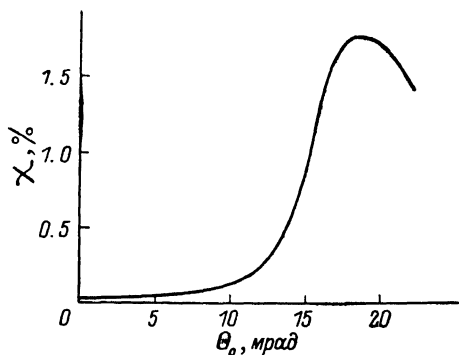


Рис. 1.

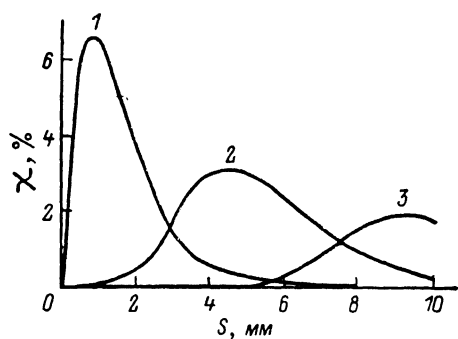


Рис. 2.

и число узлов варьировались в зависимости от параметров пучка и кристалла. Межплоскостной потенциал вычислялся по формуле

$$U(x) = \frac{Z_1 l}{\Omega_0} \sum_{G_x} \frac{4\pi [Z_2 - F(G_x)]}{G_x^2} S(G_x) \exp\left[-\frac{1}{2} K(G_x)\right] e^{iG_x x},$$

где Ω_0 — объем элементарной ячейки; $G_x = 2\pi n_x/d$ — вектора обратной решетки, перпендикулярные выбранной кристаллографической плоскости; $S(G_x)$ — структурный фактор; $K(G_x)$ — фактор Дебая—Валлера; атомные форм-факторы $F(G_x)$ брались из [12].

Аналогично вычислялись ядерная и электронная плотности. Численные расчеты проводились для изогнутых (111) плоскостей Si, что соответствует экспериментам ЛИЯФ [3, 4]. Доля каналированных частиц ДКЧ вычислялась по формуле

$$\chi = \int_{\varepsilon_1 < \varepsilon_c} d\varepsilon_1 \Phi_1(\varepsilon_1, t).$$

На рис. 1 представлена зависимость ДКЧ от угла влета пучка протонов в ИК кремния с энергией 1 ГэВ (угловая ширина пучка $\Delta\theta_0 = 1$ мрад, толщина кристалла $S = 1$ см, радиус изгиба $R = 46$ см). Максимум распределения соответствует ОЗ вблизи задней границы кристалла, так как длина деканализации в данном случае ($l_c \approx 1.3$ мм) меньше толщины кристалла. Ширина распределения на рис. 1 обусловлена в основном МР в кристалле.

На рис. 2 представлены зависимости $\chi(s)$ (s — глубина в кристалле для протонного пучка с $E_{\text{квн}} = 1$ ГэВ, $\Delta\theta_0 = 1$ мрад, $R = 46$ см) для различных углов

влета пучка (Θ_0 , мрад: 1 — 2, 2 — 10, 3 — 20). Максимумы $\chi(s)$ соответствуют точкам ОЗ.

Заметим здесь, что оптимальные угловые параметры ОЗ можно получить из следующих соображений. Пучок БЗЧ с начальной шириной $W = p \Delta\Theta_0$ «дрейфует» в пространстве поперечных импульсов p_{\perp} со «скоростью» $\sim pv/R$ из начальной точки $-p\Theta_0$ по направлению к каналу. Характерное время пребывания в канале захваченных частиц $t_c \sim l_c/v$. Максимальное число частиц в канале достигается при условии $R\sqrt{W^2 + (\Delta W)^2}/pv \leq t_c$, где $\Delta W = (E_s/pv)\sqrt{R\Theta_0/L_{\text{рад}}}$ — «дополнительная» ширина пучка, приобретенная в ИК

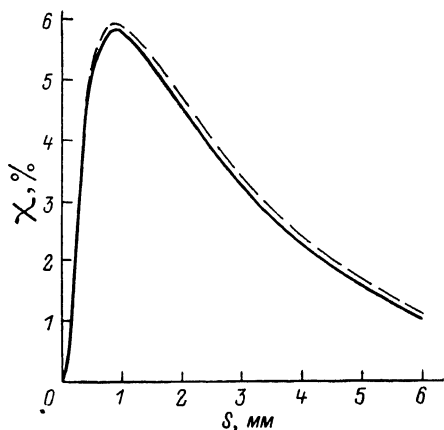


Рис. 3.

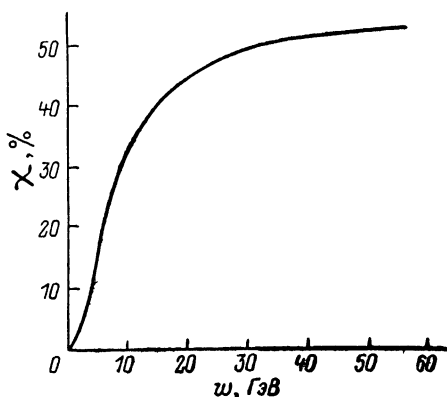


Рис. 4.

вследствие МР на пути к области захвата. Отсюда получим условие на оптимальные угловые параметры пучка

$$\sqrt{\Delta\Theta_0^2 + \left(\frac{E_s}{pv}\right)^2 \frac{R\Theta_0}{L_{\text{рад}}}} \leq \frac{l_c}{R}.$$

Для экспериментов [3, 4] имеем отсюда

$$\sqrt{\Delta\Theta_0^2 + \Theta_0^2} \leq 2.61, \quad (11)$$

где $\Delta\Theta_0$, Θ_0 измеряются в мрад. Кривая 1 на рис. 2 удовлетворяет неравенству (11), кривые 2, 3 — нет, что подтверждается их поведением.

Свойство «масштабной инвариантности» показано на рис. 3, где представлена зависимость $\chi(s)$ для релятивистских ядер в ИК кремния ($R=31$ см) для пучка ядер C^{+8} с $E_{\text{кйн}}=8.4$ ГэВ (сплошная кривая) и пучка ядер Ba^{+56} с $E_{\text{кйн}}=70$ ГэВ (штриховая кривая). Масштабные параметры равны соответственно $\omega_1=2.20$ ГэВ, $\omega_2=2.06$ ГэВ. Угол влета пучков $\Theta_0=1$ мрад, угловая ширина $\Delta\Theta_0=0.8$ мрад.

На рис. 4 приведена зависимость доли каналированных ядер от значения масштабного параметра в ИК кремния на глубине $s=10$ мм ($R=31$ мм) для узких пучков $\Delta\Theta_0=\Theta_c$, $\Theta_0=0$. При вычислениях пренебрегалось процессами подхвата электронов ядрами, так как энергия ядер выбиралась достаточно большой [13].

Литература

- [1] Tsyanov E. N. Fermilab Preprint. ТМ-684. Batavia, 1976.
- [2] Сумбаев О. И. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 11. С. 2067—2077.
- [3] Андреев В. А., Баублис В. В., Дамаскинский Е. А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1982. Т. 36. Вып. 9. С. 340—343.
- [4] Андреев В. А., Баублис В. В., Дамаскинский Е. А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 39. Вып. 12. С. 58—61.
- [5] Андреев В. А., Баублис В. В., Дамаскинский Е. А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 44. Вып. 2. С. 101—103.

- [6] *Таратин А. М., Воробьев С. А.* // ЖТФ. 1985. Т. 55. Вып. 2. С. 98—102.
- [7] *Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Пятаевский Л. П.* Физическая кинетика. М.: Наука, 1979. 527 с.
- [8] *Линдхард Й.* // УФН. 1969. Т. 99, № 2. С. 249—296.
- [9] *Кумахов М. А., Ширмер Г.* Атомные столкновения в кристаллах. М.: Атомиздат, 1980. 403 с.
- [10] *Белошицкий В. В., Кумахов М. А.* // ДАН СССР. 1973. Т. 221. № 4. С. 846—849.
- [11] *Taratyn A. M., Vorobiev S. A.* // Phys. St. Sol. B. 1986. Vol. 133. P. 511—516.
- [12] *Doyle P. A., Turner P. S.* // Acta Cryst. 1968. Vol. 24 A. P. 395—397.
- [13] *Beiz H. D.* // Rev. Mod. Phys. 1972. Vol. 44. N 3. P. 465—539.

Московский
инженерно-физический институт

Поступило в Редакцию
5 января 1988 г.

